PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-219942

(43)Date of publication of application: 08.08.2000

(51)Int.CI.

C22C 38/00 B22D 11/06 9/04 B22F H01F 1/06

(21)Application number: 11-022834

(71)Applicant: SHIN ETSU CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

29.01.1999

(72)Inventor: HASHIMOTO TAKAHIRO

SATO KOJI

MINOWA TAKEHISA

(54) ALLOY THIN STRIP FOR RARE EARTH MAGNET, ALLOY FINE POWDER AND THEIR PRODUCTION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase the density of a sintered body at a low temp. by controlling its thickness to a specified range, allowing it to contain chill crystals of specified grain size by a specified volume ratio in the vicinity of the cooling face and composing the balance of granular crystals of specified grain size and columnar crystals of specified size.

SOLUTION: By a roll rapid cooling method, an alloy thin strip for the raw material of a permanent magnet having 30 to 1000 μm thickness, contg. chill crystals of $\leq 3~\mu m$ grain size by 1 to 30% volume ratio in the vicinity of the cooling face, and in which the balance other than the chill crystals is composed of granular crystals of 3 to 50 μ m grain size and columnar crystals of 3 to 100 μm minor axis and 20 to 600 μm major axis can be obtd. By pulverizing this thin strip, fine powder having a grain size distribution in which the ones of $\leq 3~\mu m$ average grain size are contained by 1 to 30 vol., and the grain size of the balance is 3 to 10 μ m can easily be obtd. By using thin fine powder, sintering can be executed at a temp. lower by 20 to 100° C compared to the case in which fine powder having a uniform grain size distribution is used, and its coercive force increases.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.08.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3693838

[Date of registration]

01.07.2005

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-219942 (P2000-219942A)

平成12年8月8日(2000.8.8) (43)公開日

(51) Int.Cl. ⁷ C 2 2 C 38/00 B 2 2 D 11/06 B 2 2 F 9/04	說別記号 303 360	FI C22C 38/00 303D 4E004 B22D 11/06 360B 4K017 B22F 9/04 E 5E040 D
	審査請习	C R 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顯平11-22834	(71) 出願人 000002060 信越化学工業株式会社
(22)出願日	平成11年1月29日(1999.1.29)	東京都千代田区大手町二丁目6番1号 (72)発明者 橋本 貴弘

福井県武生市北府2丁目1番5号 信越化

学工業株式会社磁性材料研究所内

佐藤 孝治 (72)発明者

福井県武生市北府2丁目1番5号 信越化

学工業株式会社磁性材料研究所内

(74)代理人 100062823

(外2名) 弁理士 山本 亮一

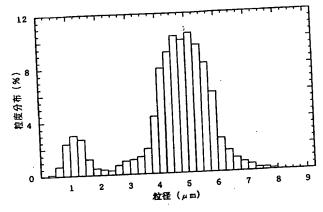
最終頁に続く

希士類磁石用合金薄帯、合金微粉末及びそれらの製造方法 (54) 【発明の名称】

(57)【要約】

【課題】 低い温度で焼結体を高密度化することを可能 とする希土類永久磁石を製造するのに適した原料と、そ の原料の調製方法を提供する。

【解決手段】 R-T-B系希圡類永久磁石原料用の合 金容湯をロール急冷法で急冷して、薄帯の厚さが30~ 1000μmであり、冷却面近傍に体積率で1~30% の粒径 3 μ m以下のチル晶を有し、残部は、粒径 3 ~ 5 0μmの粒状結晶、及び短軸が3~100μm、長軸が 20~600μmの柱状結晶からなるものとする。ま た、前記永久磁石原料用合金薄帯を粗粉砕し、その粗粉 砕粉末を更に微粉砕して得られる微粉末であって、粒径 3μm以下の微粉末が1~30%含まれ、残部の粒径が 実質的に $3\sim1$ $0~\mu$ m であるものとする。 粗粉砕する方 法が、永久磁石原料用合金薄帯に水素を吸蔵させた後脱 水素化を行う方法であり、かつ、微粉砕がジェットミル により行われることであることが好ましい。



30

【特許請求の範囲】

【請求項1】 合金溶湯をロール急冷法で急冷して得ら れる実質的にR2 T14B(Rは希土類元素、Tは遷 移金属を表す) からなる薄帯であって、薄帯の厚さが3 0~1000μmであり、冷却面近傍に体積率で1~3 0%の粒径3μm以下のチル晶を有し、残部は、粒径3 ~50μmの粒状結晶、及び短軸が3~100μm、長 軸が20~600μmの柱状結晶からなることを特徴と する永久磁石原料用合金薄帯。

【請求項2】 請求項1記載の永久磁石原料用合金薄帯 を粗粉砕し、その粗粉砕粉末を更に微粉砕して得られる 微粉末であって、粒径3μm以下の微粉末が1~30v o 1%含まれ、残部の粒径が実質的に3~10μmであ ることを特徴とする永久磁石原料用合金微粉末。

【請求項3】 請求項1記載の永久磁石原料用合金薄帯 を粗粉砕し、別途粗粉砕した粒界用助剤と混合し、その 混合粗粉砕粉末を更に微粉砕して得られる微粉末であっ て、粒径3μm以下の微粉末が1~30νο1%含ま れ、残部の粒径が実質的に3~10μmであることを特 徴とする永久磁石原料用合金微粉末。

【請求項4】 請求項1記載の永久磁石原料用合金薄帯 を粗粉砕し、別途粗粉砕した粒界用助剤と混合しまたは 混合しないで、粗粉砕粉末を更に微粉砕することを特徴 とする、請求項2または請求項3記載の永久磁石原料用 合金微粉末を製造する方法。

【請求項5】 請求項4記載の発明において、永久磁石 原料用合金薄帯を粗粉砕する方法が、永久磁石原料用合 金薄帯に水素を吸蔵させた後脱水素化を行う方法であ り、かつ、微粉砕がジェットミルにより行われることを 特徴とする、永久磁石原料用合金微粉末を製造する方

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気特性に優れた 希土類永久磁石を製造するのに適した原料とその原料の 製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】希土類永久磁石は、優れた磁気特性と経 済性のため電気・電子機器の分野で多用されており、近 年益々その高性能化が要求されている。これら希土類永 久磁石の内R-T-B系希土類永久磁石(RはN d を主 体とした希土類元素、TはFe、又はFe及びCoであ る遷移金属)は、希土類コバルト磁石に比べたとき、主 要元素であるNdがSmより豊富に存在すること、高価 なCoを多用しないこと、から原材料費が安価であり、 磁気特性も希土類コバルト磁石を遙かに凌ぐ、極めて優 れた永久磁石である。従来、R-T-B系希土類永久磁 石原料用合金は、合金溶湯を金型に鋳造する金型鋳造法 により製造されてきた。この合金の冷却凝固過程におい て初晶γーFeが析出し、それが冷却後αーFeとして

偏析する。α-Feは永久磁石製造工程の中の微粉砕工 程において、その粉砕能力を悪化させ、焼結工程後の磁 石に残存すれば磁気特性の低下をもたらす。そのため、 高温で長時間にわたる均質化熱処理を施してαーΓ e を 消失させることが必要となるが、この均質化熱処理によ り合金中の主相 (R2 T14B) の結晶粒径が粗大化 し、磁気特性を低下させると共に、製造コストも上昇さ せてしまう。そこで、ストリップキャスティング法等の 急冷技術を用いて、α-Feの偏析を抑制すると共に、 主相の結晶粒径を細かくした永久磁石原料用合金を製造 し、それを用いて永久磁石を製造することが報告されて いる。

【0003】特許第2665590号では、主相(R2 T14B) 結晶が短軸3~20μmの均質な柱状結晶 であり、この永久磁石原料用合金を用いると保磁力(i Hc) の高い磁石を製造できるとしている。特許第26 39609号では、冷却速度10~500℃/秒で均一 に凝固させ、主相の結晶粒径が短軸 0. 1~50 μm、 長軸0. 1~100μmである永久磁石原料用合金を製 造し、これを用いることにより磁石の残留磁束密度(B 20 r) を上昇させている。特開平7-176414号で は、平均粒径3~50μmの柱状結晶の主相用母合金と 平均粒径 0. 1 ~ 2 0 μ m の粒界用助剤とを混合し、水 素を吸蔵させる方法で粉砕性を上げ、更に磁気特性も上 げている。特開平9-170055号では、鋳造後の8 00~600℃の冷却を10℃/秒以下に制御すること で、主相の平均粒径が20~100μmで、Νdリッチ 相間隔が15μm以下の合金をつくり、残留磁化を上昇 させている。これらどの報告においても、平均粒径の揃 った均質な原料用合金を用いて、粒度分布が均一な微粉 を得ることで、磁気特性を向上させているのが特徴であ

【0004】希土類永久磁石は、金型鋳造法、又は急冷 法によって製造された原料用合金を粉砕して得られた微 粉末を磁場中で加圧成型した後、真空中で焼結するとい う粉末冶金工程で製造される。希土類永久磁石における 焼結工程は、液相焼結と言われるもので、微粉末の成型 体を約1100℃(組成によって違う)に加熱すること で液相量が増え、収縮して密度が上がり、残留磁束密度 が上がることを利用している。焼結終了後に冷却する と、液相にならなかった主相の周りを融点の低い相であ るR (Nd) リッチ相が囲み、平均粒径3~10μmの 主相が分散することで保磁力が発生する。残留磁束密度 を上げるには焼結密度を上げる必要があり、主相が完全 に液相になってしまう温度を上限として、焼結温度を高 くした方が良い。

【0005】一方、保磁力は、焼結温度を高くすればい いというものではなく、一般的には残留磁束密度が最大 となる温度よりも約100℃低い温度で最大となってい 50 た。別の言い方をすると、保磁力は、焼結体密度が真密

度の約90%に上がったところで最も高くなり、それ以上に加熱すると、主相が粒成長を起こして粒径が大きくなり、主相の分散性が低下するので、保磁力は低下してしまう。特に、真密度の99.5%を超える焼結体密度になるまで加熱すると、主相が急激に粒成長してを高速で加熱すると共に、角型性も低下してしまう。そこで、一般的には、残留磁東密度と保磁力とのバランスを考えて、焼結体密度が真密度の98~99.5%になるような温度が最適焼結温度と比較して低い温度がおら、これまでの最適焼結温度と比較して低い温度で結体密度を上げることが可能となれば、焼結体中の主相の粒径を大きくさせないから、残留磁東密度の値を損なうことなしに保磁力を大きくすることが可能となる、と考えられる。

【0006】保磁力を大きくすることを目的として最適 焼結温度を下げるには、液相になり易い、融点の低い相 であるRリッチ相を増やす組成にする方法と、微粉末の 粒径を細かくする方法とがある。前者の場合、確かに焼 結温度が下がり保磁力が上昇するが、相対的に主相の割 合が低下してしまい、残留磁束密度が低下してしまうの で好ましくない。後者の場合、微粉末の表面積が増える ことにより、酸素濃度が増えてしまう。酸素はRと反応 してR2 O3 となり、Rリッチ相の量が減ってしまう ので好ましくない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上に述べた 点を踏まえて、低い温度で焼結体を高密度化することを 可能とする希土類永久磁石を製造するのに適した原料 と、その原料の製造方法を提供することを目的とする。 【0008】

【課題を解決するための手段】本発明は、その目的を達 成するために、合金溶湯をロール急冷法で急冷して得ら れる実質的にR2 T14B (Rは希土類元素、Tは遷 移金属を表す) からなる薄帯であって、薄帯の厚さが3 0~1000μmであり、冷却面近傍に体積率で1~3 0%の粒径 3μm以下のチル晶を有し、残部は、粒径 3 ~50μmの粒状結晶、及び短軸が3~100μm、長 軸が20~600μmの柱状結晶からなるものとする。 また、前記永久磁石原料用合金薄帯を粗粉砕し、その粗 粉砕粉末を更に微粉砕して得られる微粉末であって、粒 径3μm以下の微粉末が1~30vol%含まれ、残部 の粒径が実質的に 3~10μmであるものとする。 更 に、永久磁石原料用合金薄帯を粗粉砕し、別途粗粉砕し た粒界用助剤と混合し、その混合粗粉砕粉末を更に微粉 砕して得られる微粉末であって、粒径3μm以下の微粉 末が1~30vol%含まれ、残部が粒径が実質的に3 \sim 1 O μ mであるものとする。また、永久磁石原料用合 金微粉末を製造するために、永久磁石原料用合金薄帯を 粗粉砕し、別途粗粉砕した粒界用助剤と混合しまたは混 合しないで、粗粉砕粉末を更に微粉砕する。永久磁石原 料用合金薄帯を粗粉砕する方法が、永久磁石原料用合金 薄帯に水素を吸蔵させた後脱水素化を行う方法であり、 かつ、微粉砕がジェットミルにより行われることである ことが好ましい。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明は、チル晶と粒状結晶部分と柱状結晶部分とが混 在する結晶組織の永久磁石原料用合金薄帯を用いること で、低い温度で焼結体を高密度化することを可能とし、 焼結体中の主相が粒成長することなく粒径を細かく保 ち、高残留磁束密度で高保磁力のR-T-B系希土類永 久磁石を得ることができるとの知見を基本としている。 本発明者等は、ロール急冷法によれば、冷却面近傍に体 積率で1~30%の粒径3μm以下のチル晶を有し、チ ル晶以外の残部は粒径3~50μmの粒状結晶、及び短 軸3~100μm、長軸20~600μmの柱状結晶か らなる永久磁石原料用合金薄帯を得ることができるこ と、また、その永久磁石原料用合金薄帯を用いること で、平均粒径3μm以下のものが1~30%含まれ、残 部の粒径が3~10μmである粒度分布を持つ微粉末を 容易に得ることができ、その微粉末を用いることで、従 来の均一な粒度分布を持つ微粉末を用いた時よりも20 ~100℃低温で焼結できるようになり、保磁力が大き くなることを見出した。

【0010】微粉末の平均粒径を細かくする方法で最適焼結温度を下げて保磁力を上昇させようとした場合、既に述べたように、酸素濃度が上昇するために、磁石を高特性化するのには限界があった。しかし、平均粒径を変えずに、細かい粒径のものが含まれる微粉末を用いると、磁石を高特性化することができる。具体的には、粒径3 μ m以下のものが1 \sim 30%含まれ、残部の粒径が3 \sim 10 μ mである粒度分布を持った微粉末を用いると、粒径3 μ m以下の微粉末が存在するために最適焼結温度は20 \sim 100 $^{\circ}$ C低くなり、保磁力が上昇する。この場合、平均粒径がほぼ同じなので、酸素濃度の上昇はほとんどない。

【0011】粒径 3μ m以下のものが $1\sim30$ %含まれ、残部の粒径が $3\sim10\mu$ mである粒度分布を持った 微粉末を製造するには、均一な結晶組織の原料用合金を使っていたのでは難しい。理由は以下の通りである。

- (1) 均一な結晶組織の原料用合金を使うと、粉砕された微粉末は均一な粒度分布となり易い。
- (2) 微粉砕条件の変更により同じ平均粒径で粒径3μm以下の微粉末を増やそうとすれば、粒径10μm以上の大きなものも混入してしまう。
- (3) 粒径 3 μ m以下の微粉末と平均粒径 3~10 μ m の微粉末とを別々に粉砕して混合する方法では、完全には混ざらない。また、微粉末は非常に酸化し易く、酸素濃度が上昇してしまうので、Vブレンダー等を用いて混合する工程を追加することは、好ましいものとは言えな

30

い。

【0012】したがって、平均粒径3 μ m以下のものが 1~30%含まれ、残部の粒径が3~10μmである粒 度分布を持つ微粉末を製造するには、チル晶を含む複数 の相が混在した結晶組織の原料用合金を使えば良いこと になる。チル晶を含む複数の相が混在した結晶組織を有 する永久磁石原料用合金は、合金溶湯をロール急冷法で 急冷して得られる薄帯によって実現される。原料用合金 薄帯は、単ロール法、又は双ロール法により容湯を急激 に冷却して製造される。合金容湯をロールに接触させて 冷却凝固させると合金薄帯ができるが、合金薄帯中の冷 却速度は一定ではない。例えば単ロール法の場合、合金 薄帯はロール接触面から非接触面へと順に冷却される が、合金薄帯が冷却されると同時にその熱量がロールへ と移動してロールの温度が上昇する。よって、合金薄帯 がロールと接触している間は合金薄帯とロールの温度差 が順次小さくなり、冷却速度が遅くなっていく。つま り、合金薄帯のロール接触面は冷却速度が速いが、非接 触面は冷却速度が遅い。

【0013】合金薄帯がロールから剥がれた後1回転す 20 る間にロールは冷却され、再び合金容湯がロールに接触 して合金薄帯が製造される。ロールの材質、厚さ、直 径、回転数、冷却水温度、冷却水流量等を変えることで 冷却速度を変えることができ、それにより、複数の相が 混在した結晶組織を有する原料用合金を製造することが できる。具体的には、ロール接触面近傍では約1000 0℃/秒以上の冷却速度で、粒径3μm以下のチル晶を つくる。次の層では約1000℃/秒~約10000℃ /秒の冷却速度で、粒径3~50μ mの粒状結晶をつく る。次の層ではロール非接触面まで約200℃/秒~約 1000℃/秒の冷却速度で、短軸3~100μm、長 軸 $2.0\sim6.0.0$ μ mの柱状結晶をつくる。ここで、長軸 が短軸の2倍未満のものを粒状結晶、2倍以上のものを 柱状結晶とする。合金薄帯中の結晶相の量的割合は、冷 却面近傍に体積率で1~30%の粒径3μm以下のチル 晶を有し、残部は、粒径3~50μmの粒状結晶、及び 短軸が3~100μm、長軸が20~600μmの柱状 結晶からなるようにする。チル晶、粒状結晶、柱状結晶 以外のものが存在しても、体積率で1%以下であれば問 題ない。チル晶の割合が体積率で1%未満では、粒径3 μ m以下の微粉末の割合が少なくなって、本発明の効果 が得られない。また、30%を超えると粒径3μm以下 の微粉末の割合が増えて、酸素濃度が上昇してしまうの で好ましくない。

【0014】得られた合金薄帯を粗粉砕する。粗粉砕 は、ブラウンミル等、通常の粉砕手段が採用され得る。 しかし、粗粉砕工程において、合金薄帯をブラウンミル 等で粗粉砕するのではなく、水素を吸蔵させた後に脱水 素化を行うという水素化粗粉砕を行うことがより好まし い。これは、水素吸蔵により格子間隔が膨張してクラッ

クが発生し、粗粉末となるのであるが、これが好ましい 理由は、微粉砕のときに粗粉末が結晶組織の粒界で割れ 易くなるからである。また、脱水素化工程では真空中で 400℃~700℃に加熱するが、加熱することで主相 から水素が十分に放出される。一合金法の場合には、得 られた粗粉末をジェットミル等により微粉砕する。ま た、二合金法の場合には、別にブラウンミル等で粗粉砕 した粒界用助剤粗粉末と混合し、混合粗粉末をジェット ミル等により微粉砕を行う。

【0015】ジェットミルでの微粉砕において、粒径3 μ m以下のチル晶は粒径 3 μ m以下の微粉末に粉砕さ れ、他の部分は粒径3~10μmの微粉末になるまで粉 砕される。微粉末の粒径別の割合は、粒径 3 μ m以下の 微粉末が1~30vol%含まれ、残部の粒径が実質的 に3~10μmであるようにする。粒径3μm以下の微 粉末が1vol%以下では、液相焼結の温度が高温にな り、30vol%を超えると、酸素濃度が上昇してしま って、必要な磁気特性が得られない。得られた微粉末 は、配向させるために磁場中で加圧成型する。その後、 成型体は真空中で、従来の方法で調製された微粉末を使 用したときと比べて20~100℃低い温度で、焼結す る。本発明について、薄帯内に複数の結晶組織がある場 合のその割合と、それによる効果について説明してきた が、要するに、厚さ等を含めて薄帯内にばらつきがあっ ても、全体として体積率で1~30%の粒径3μm以下 のチル晶を有し、残部は粒径 3 ~ 5 0 μ mの粒状結晶、 及び短軸3~100μm、長軸20~600μmの柱状 結晶からなっていればよい。これは薄帯の製造条件が広 いという意味を持っており、製造を安定して続けていく 上で、本発明の合金薄帯を使うことは非常に好ましい。 [0016]

【実施例】以下、本発明を実施例を挙げて説明するが、 本発明はこれらに限定されるものではない。

[実施例1] 組成式12. 5Nd-6. 0B-1. 5C o-80.0Fe(各原子%)の組成の金属溶湯を、A r 雰囲気中で単ロール法によって冷却して、合金薄帯を 製造した。この合金薄帯は、平均厚さが約240μmで あり、冷却面近傍に体積率で12%のチル晶、それから 体積率 6 %の粒径 5 ~ 2 0 μ m の粒状結晶、残部は短軸 $5\sim30\,\mu$ m、長軸 $50\sim230\,\mu$ mの柱状結晶からな っていた。この合金薄帯の断面の代表的な偏光顕微鏡に よる組織写真を図1に示す。断面写真の下部がロール接 触面であり、ここにチル晶ができている。製造した合金 薄帯を、ブラウンミルにて平均粒径200μ mに粗粉砕 して主相用母合金とし、これを90重量%、別途ブラウ ンミルにて平均粒径200μmに粗粉砕した20.0Ν d-10.0Dy-6.0B-44.0Co-20.0Fe (各原子%) の組成の粒界用助剤を10重量%、の 割合で混合し、ジェットミルにより微粉砕を行った。

【0017】得られた微粉末は、平均粒径4.5μmで

50

あり、その内粒径 3 μ m以下のものが 8 % あり、その平均粒径は 1.8 μ mであった。この微粉末の粒度分布を図5に示す。 3 μ m以下にもう一つのピークが見られる。得られた微粉末を 15 k O e の磁場中で配向させながら、1 t o n / c m² の圧力で加圧成型した。この成型体を真空中で 1050℃で2時間焼結し、その後 A r 雰囲気中で1時間時効熱処理を行い、磁石合金を作製した。

【0018】 [実施例2] 実施例1と同じ合金薄帯を用いて、水素化粗粉砕で粗粉砕した。水素化粗粉砕は、常 10 温で2時間水素吸蔵処理を行い、その後真空中で600 \mathbb{C} で2時間加熱して脱水素化処理を行った。その後は実施例1と同様にして微粉末を得た。得られた微粉末の平均粒径は4.5 μ mであり、その内粒径3 μ m以下のものが13%あり、その平均粒径は1.4 μ mであった。この微粉末の粒度分布を図6に示す。3 μ m以下で見られるもう一つのピークがより高くなった。この微粉末を用いて、焼結温度を、実施例1より10 \mathbb{C} 低い、1040 \mathbb{C} にしたこと以外は実施例1と同じ方法で磁石合金を作製した。この1040 \mathbb{C} は、この例で用いた微粉末に 20 おける最適焼結温度である。

【0019】 [実施例3] 実施例1と同じ組成で、単ロール法にて、平均厚さ約 260μ mであり、冷却面近傍に体積率で10%のチル晶、それから体積率で29%の粒径 $5\sim30\mu$ mの粒状結晶、残部は短軸 $5\sim30\mu$ m、長軸 $50\sim250\mu$ mの柱状結晶からなる合金薄帯を製造した。この合金薄帯の断面の代表的な偏光顕微鏡による組織写真を図2に示す。その他は実施例2と同じ方法で磁石合金を作成した。

【0020】 [実施例4] 実施例1と同じ組成で、単ロール法にて、平均厚さ約 250μ mであり、冷却面近傍に体積率で13%のチル晶、それから体積率で70%の粒径 $5\sim40\mu$ mの粒状結晶、残部は短軸 $5\sim30\mu$ m、長軸 $50\sim230\mu$ mの柱状結晶からなる合金薄帯を製造した。この合金薄帯の断面の代表的な偏光顕微鏡による組織写真を図3に示す。その他は実施例2と同じ方法で磁石合金を作成した。

【0021】 [比較例1] 実施例1と同じ組成で、単ロール法によって、平均厚さが約270μmであり、冷却面近傍に体積率で10%の粒径5~35μmの粒状結

晶、残部が短軸 5 ~ 3 0 μ m、長軸 5 0 ~ 2 7 0 μ mの柱状結晶からなる合金薄帯を製造した。この合金薄帯の代表的な偏光顕微鏡による組織写真を図4に示す。その後、焼結温度を実施例2より40℃高い、この合金の最適焼結温度である1080℃にした以外は、実施例2と同じ方法で磁石合金を作製した。途中得られた微粉末の平均粒径は4.6 μ mであり、その内粒径3 μ m以下のものが2%あり、その平均粒径は2.6 μ mであった。この微粉末の粒度分布を図7に示す。3 μ m以下にピークは見られない。

【0022】 [比較例2] 焼結温度を実施例2と同じ1 040℃にした以外は比較例1と同じ合金薄帯を用い て、同じ方法で磁石合金を作製した。

[比較例3] 実施例1と同じ組成で、単ロール法によっ て合金薄帯を製造した。得られた合金薄帯は、平均厚さ が約1000μmであり、冷却面近傍に体積率で6%の 粒径5~50μmの粒状結晶、それから64%の短軸5 ~50μm、長軸200~700μmの柱状結晶、非冷 却面側に体積率で30%の平均粒径8.2μmのα- F e が偏析している部分からなる合金薄帯であった。 α-F e を消去するために、合金薄帯に1080℃で20時 間の均質化熱処理を行った。この時の主相結晶は粒径2 00~800μmの粒状結晶であった。その後、焼結温 度を、実施例2より60℃高い、この合金薄帯を用いた ときの最適焼結温度である1100℃にした以外は、実 施例2と同じ方法で磁石合金を作製した。途中得られた 微粉末の平均粒径は4.6μmであり、その内粒径3μ m以下のものが2%あり、その平均粒径は2. 7μmで あった。

【0023】表1に、二合金法で磁石を作製した実施例 1~4と比較例1~3について、合金薄帯の厚さ、結晶 組織とその割合、αーFeを消去するための均質化熱処 理および水素化粗粉砕の有無、微粉末の平均粒径と3μ m以下の割合、得られた磁石合金の焼結温度、主相の平均粒径、磁気特性(残留磁束密度Br、保磁力iHc、 最大エネルギー積(BH)max)、及び焼結体密度ρを 示す。

[0024]

【表1】

40

9

二合金法=合金薄帯 (12.5Md-6.0B-1.5Co-80.0Fe) + 粒界用助剂 (20.0Md-10.0Dy-6.0B-44.0Co-20.0Fe)

	合金海带	(比較例3のみ均質化熱処理後)					傲 粉 末		
	厚さ (μm)	チル島 (%)	粒状結晶 (%)	柱状結晶 (%)	均 質 化	水素化	平均粒径(μm)	3 μ m以下 の割合 (%)	3 μm以下の平 均粒径 (μm)
実施例1	240	12	6	82	無	無	4.5	8	1.8
実施例2	240	12	6	82	無	有	4.5	13	1.4
実施例3	260	10	29	61	無	有	4.5	11	1.4
実施例4	250	13	70	17	無	有	4.4	14	1.4
比較例1	270	0	10	90	無	有	4.6	2	2.6
比較例2	270	0	10	90	無	有	4. 6	2	2.6
比較例3	1000	0	100	0	有	有	4. 6	2	2.7

		Æ	結体(日	並石合金))	
	焼精温度 (C)	平均粒径 (μπ)	Br (kG)	iHc (k0e)	(BH) nax (MGOe)	(g/∞)
実施例 1	1050	6.0 .	13.6	15.3	44.5	7.56
実施例2	1040	5.5	13.6	16.3	44.6	7.54
実施例3	1040	5.5	13.6	16.2	44.6	7. 55
実施例4	1040	5.4	13.6	16.5	44.5	7. 55
比較例1	1080	6.9	13.6	13.7	44.6	7. 54
比較例2	1040	5.4	12.6	16.3	38.4	7. 20
比較例3	1100	7.3	13.5	12.3	44.0	7. 55

【0025】チル晶が存在しない合金薄帯を用いた比較 例1は、焼結体密度を十分に上昇させるためには、10 80℃で焼結する必要があった。それに対して、チル晶 が存在している実施例1~4では、1050℃又は10 40℃で焼結体密度が十分に上昇しているため、比較例 1と比べて焼結体中の主相が粒成長せず、平均粒径が小 さく保たれるために、iHcが高くなっている。また、 実施例1よりも、水素化粗粉砕をした実施例2の方が、 3 μ m以下の微粉末の割合が多くなり、最適焼結温度が 更に低くなり、得られた磁石合金の特性においてもより 望ましい結果が得られた。比較例1と同じ合金薄帯を用 いて同じ方法で、焼結温度だけ実施例2と同じにしたの が比較例2であるが、焼結体密度が低く、Br及び(B H) max が低い結果となっている。また、実施例2、 3、4は、チル晶の割合がほぼ同じで、粒状結晶と柱状 結晶の割合を変化させたものであるが、有意差はなかっ た。

【0026】比較例3は、扁析したα-Feを消去する ために均質化熱処理を行ったため、合金薄帯中の結晶組 織は粒状結晶が100%となり、表1には示していない*

*が上述のとおり、結晶粒径が大きくなってしまった場合で、金型鋳造法にて作製した合金塊を均質化熱処理した場合とほぼ同じ結晶粒径となった。この場合、焼結体密度が上昇してBrを上昇させるためには1100℃で焼結する必要が有り、焼結体中の主相が粒成長し、平均粒20 径が大きくなってしまうために、iHcが低くなっている。以上のことから、チル晶を有する合金薄帯を用いて磁石合金を製造することは、磁気特性の向上に有効であることが分かる。

10

【0027】次に、組成式13.2Nd-0.8Dy-6.0B-4.5Co-75.5Fe(各原子%)の組成で、一合金法により磁石合金を製造したものが実施例5~8と比較例4~6であり、実施例5~8と比較例4~6についての、表1と同様の項目の測定結果を、表2に、また、実施例5における合金薄帯の断面の代表的な偏光顕微鏡による組織写真を図4に、それぞれ示す。一合金法での製造方法は、粒界用助剤を混合しない以外は二合金法と同じである。

[0028]

【表 2】

一日五公二日五公	存分 (12.50	10-6. UB-1. 5	100-80. Ure)						
	合金薄帯 (比較例6のみ均質化熱処理後)						微 粉 末		
	厚さ (μm)	チル晶(%)	粒状結晶 (%)	柱状結晶 (%)		水紫化 粗粉碎	平均粒径(μm)	3 μ m 以下 の割合 (%)	3 μm以下の平 均位径 (μm)
実施例5	290	10	11	79	無	無	4.6	7	1.9
実施例 6	290	10	11	79	無	有	4.6	11	1.6
実施例7	280	11	42	47	無	有	4.5	12	1.6
夷施例8	290	10	75	15	無	有	4.6	11	1.6
比較例 4	300	0	6	94	無	有	4.6	2	2.7
比較例 5	300	0	6	94	無	有	4.6	2	2. 7
比較例 6	1000	0	100	0	有	有	4.7	1	2. 8

	焼結体(磁石合金)							
	焼精温度	平均粒径(μπ)	Br (kG)	iHc (k0e)	(BH) max (MGOe)	(g/cc)		
実施例 5	1040	5.8	13.4	15. 4	43.5	7.56		
実施例 6	1030	5.4	13.4	16.1	43.5	7.57		
実施例7	1030	5.4	13.4	16.3	43.5	7.56		
実施例8	1030	5.4	13.4	16.2	43.6	7.57		
比較例4	1070	6.6	13.4	14.6	43.4	7. 55		
比較例 5	1030	5.5	12.5	16.0	37.9	7. 22		
比較例 6	1090	7.2	13. 2	12.9	42, 2	7.55		

【0029】チル晶を有する合金薄帯を用いた実施例5~8の磁気特性が高くなっており、一合金法の場合にお

いても、チル晶を有する合金薄帯を用いて磁石合金を製 50 造することは、磁気特性の向上に有効であることを示し

ている。

[0030]

【発明の効果】以上に説明したように、本発明の微粉末を用いて磁石合金を製造すれば、残留磁束密度 Br、最大エネルギー積(BH)max を損なうことなく、焼結温度を低めて保磁力 i Hcを高めることができる。また、本発明の合金薄帯を用いることにより、平均粒径を変えることなしに粒径 3 μ m以下の微粉末の割合を高めることができる。また、冷却面(ロール接触面)と非冷却面(ロール非接触面)との間の全てにわたり均一な結晶粒 10径を有する合金薄帯よりも、複数の相を持つ合金薄帯の方が製造条件が広いので、製造を安定して続けていくことが容易となり、本発明の合金薄帯を使うことは非常に好ましい。

11

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例1における合金薄帯の偏光顕微鏡による組織写真である。

【図2】 実施例3における合金薄帯の偏光顕微鏡による組織写真である。

【図3】 実施例4における合金薄帯の偏光顕微鏡による組織写真である。

【図4】 実施例5における合金薄帯の偏光顕微鏡による組織写真である。

【図5】 実施例1における微粉末の粒度分布を示すグラフである。

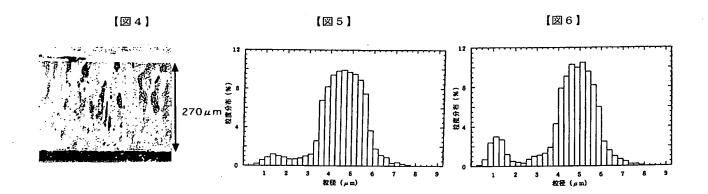
【図6】 実施例2における微粉末の粒度分布を示すグラフである。

【図7】 比較例1における微粉末の粒度分布を示すグラフである。

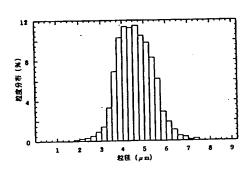
[図1] [図2] [図3]

240μm

250μm







フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7 識別記号

H01F 1/06

FΙ

テーマコード(参考)

HO1F 1/06

(72) 発明者 美濃輪 武久

福井県武生市北府2丁目1番5号 信越化 学工業株式会社磁性材料研究所内

Fターム(参考) 4E004 DA13 SD10

4K017 AA04 BA06 BB06 BB12 CA07

DA04 EA03 EA08 EC02

5E040 AA04 HB17 NN06 NN17

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потигр.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.